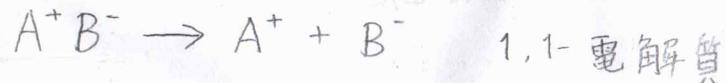


デ바이-ヒュッケル理論

★ イオンの活量



理想溶液について、イオンの全モルギブズエネルギー G_m^{ideal}

$$G_m^{ideal} = \mu_+^{ideal} + \mu_-^{ideal}$$

実在溶液では、 $\mu = \mu^{ideal} + RT \ln \gamma$

$$G_m = G_m^{ideal} + RT \ln \gamma_+ \gamma_-$$

平均活量係数 $\bar{\gamma}$

$$\bar{\gamma} \equiv (\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \dots \gamma_n)^{\frac{1}{n}} \quad \text{幾何平均}$$

$$\gamma_{\pm} \equiv (\gamma_+ \gamma_-)^{\frac{1}{2}}$$

$$G_m = G_m^{ideal} + 2RT \ln \gamma_{\pm}$$

p, q-電解質の場合

$$\begin{aligned} G_m &= p\mu_+^{ideal} + q\mu_-^{ideal} + pRT \ln \gamma_+ + RT \ln \gamma_- \\ &= G_m^{ideal} + RT \ln \gamma_+^p \gamma_-^q \end{aligned}$$

$$\gamma_{\pm} \equiv (\gamma_+^p \gamma_-^q)^{\frac{1}{p+q}}$$

非理想性の等分配

$$\mu_+ = \mu_+^{ideal} + RT \ln \gamma_{\pm}, \quad \mu_- = \mu_-^{ideal} + RT \ln \gamma_{\pm}$$

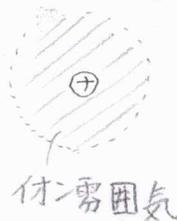
★ デバイ-ヒュッケル理論のモデルと結論

静電引力は遠距離力であり、ファンデルワールス力などの相互作用よりも大きく非理想性に寄与していると考えられる。



静電相互作用により、1つのイオンの周囲では反対の電荷をもつイオンの濃度が高くなる

↓素視化



反対の電荷がもやのように広がった状態
中心にあるイオンの電荷は、遠距離まで影響を及ぼせられなくなる(遮蔽)

→ 実効濃度の低下

・ デバイ-ヒュッケルの極限法則

濃度がとても低いとき(沈殿なし、イオンの大きさ無視)

$$\log \gamma_{\pm} = -A |z_+ z_-| I^{1/2}$$

$$I = \frac{1}{2} \sum_i z_i^2 (b_i / b^{\ominus})$$

z: イオンの価数
I: イオン強度
i: イオンの種類

・ 拡張デバイ-ヒュッケル則

$$\log \gamma_{\pm} = - \frac{A |z_+ z_-| I^{1/2}}{1 + B I^{1/2}}$$

モル濃度をCとして
 $I = \frac{1}{2} \sum_i z_i^2 C_i$
とすることもある

・ テービスの式

$$\log \gamma_{\pm} = - \frac{A |z_+ z_-| I^{1/2}}{1 + B I^{1/2}} + C I$$

25°Cの水溶液で
A = 0.0509
($b^{\ominus} = 1 \text{ mol kg}^{-1}$)
B, Cも無次元量

★ 電荷による仕事

溶質 $M_p X_q$ p, q -電解質

系に電荷を与えるのに必要なモルあたりの仕事 w_e

$$w_e = G_m - G_m^{ideal} = (p\mu_+ + q\mu_-) - (p\mu_+^{ideal} + q\mu_-^{ideal}) = pRT \ln \gamma_{\pm} + qRT \ln \gamma_{\pm}$$

$$\ln \gamma_{\pm} = \frac{w_e}{(p+q)RT}$$

★ 遮蔽の効果



対イオンの存在により、中心にあるイオンの電荷は遠距離まで影響が及ぶにくくなる

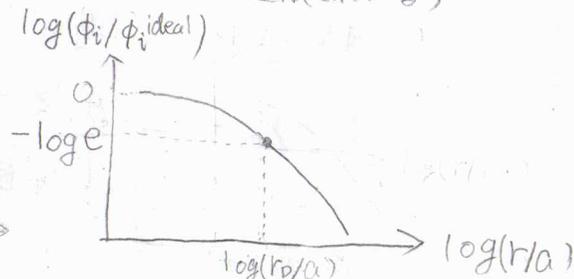
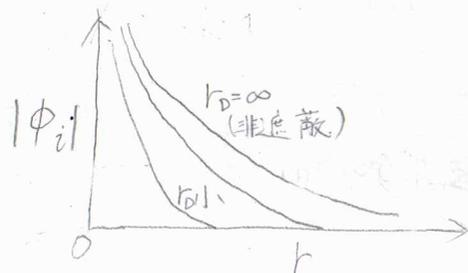
遮蔽クローンポテンシャル ϕ_i

$$\phi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{z_i e}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$$

ϵ : 誘電率 r : イオンからの距離

e : 電気素量 r_D : デバイ長

(小さいほど遮蔽されている)



★ 遮蔽クローンポテンシャル 導出



中心イオンの電荷 $z_i e$

電荷密度 $+z_i e \delta(r)$

点電荷表現



ある1つのイオンの位置を原点として、イオンの数密度変化 $\Delta p_j(r)$ 遮蔽を考慮したクローンポテンシャル $\phi(r)$ とする。

マクスウェル方程式、ガウスの法則

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon} \quad E: \text{電場} \quad \rho: \text{電荷密度}$$

$$\nabla \cdot \{-\nabla \phi(r)\} = \frac{1}{\epsilon} \{z_i e \delta(r) - \sum_j z_j e \Delta p_j\}$$

デ바이-ヒュッケル近似

十分に高い温度で、イオンはボルツマン分布に従うとする

$$\frac{p_j(r)}{p_j} = \exp\left[\frac{z_j e \phi(r)}{k_B T}\right] \quad p_j: \text{バルクの数密度}$$

$$= 1 + \frac{z_j e \phi(r)}{k_B T} + \frac{1}{2} \left[\frac{z_j e \phi(r)}{k_B T}\right]^2 + \dots$$

$$\Delta p_j(r) = \frac{z_j e p_j \phi(r)}{k_B T} \quad k_0^2 = \sum_j \frac{p_j z_j^2 e^2}{\epsilon k_B T} \text{ とおくと}$$

$$-\nabla^2 \phi(r) = \frac{1}{\epsilon} \{z_i e \delta(r) - \epsilon k_0^2 \phi(r)\}$$

整理すると

$$(\nabla^2 - k_0^2) \phi(r) = -\frac{z_i e}{\epsilon} \delta(r) \text{ 遮蔽されたポテンシャル方程式}$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} - k_0^2 \right) \phi(r) = - \frac{z_i e}{\epsilon} \rho(r)$$

$r > 0$ について、右辺は 0

一般解

$$\phi(r) = \frac{C_1}{r} \exp(-k_0 r) + \frac{C_2}{r} \exp(k_0 r)$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \phi(r) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

非遮蔽のとき, $\rho_j \ll 1, k_0 r \ll 1$

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{z_i e}{r}$$

$$C_1 = \frac{z_i e}{4\pi\epsilon}$$

$$r_0 = 1/k_0 \text{ とし}$$

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{z_i e}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right)$$

★ デバイ長とイオン強度

イオン i から r 離れたところの電荷密度 $\rho(r)$

$$\rho(r) \approx \sum_j z_j e \rho_j - \sum_j \rho_j \frac{z_j^2 e^2 \phi_i(r)}{k_B T}$$

電気的中性より

モル濃度 C_j を使えば, $N_A C_j = \rho_j$

$$\rho(r) = - \sum_j C_j z_j^2 \frac{F^2 \phi_i(r)}{RT} \quad \begin{array}{l} F: \text{ファラデー定数} \\ R: \text{気体定数} \end{array}$$

$$\text{イオン強度 } I = \frac{1}{2} \sum_j z_j^2 (b_j / b^\ominus)$$

質量モル濃度 $b_j = \frac{C_j}{\rho'}$, ρ' : 溶液の密度

$$\rho(r) = - \frac{2 I b^\ominus \rho' F^2 \phi_i(r)}{RT}$$

$$r_0 = \left(\sum_j \frac{\rho_j z_j^2 e^2}{\epsilon k_B T} \right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{\epsilon RT}{2 I b^\ominus \rho' F^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

★ 活量係数

イオン雰囲気 (イオン) によるポテンシャル $\phi_{\text{atmosphere}, i}(r)$

$$\begin{aligned} \phi_{\text{atmosphere}, i}(r) &= \phi_i(r) - \phi_{\text{central ion}, i}(r) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{z_i e}{r} \left\{ \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right) - 1 \right\} \end{aligned}$$

中心位置 ($r=0$) について

$$\phi_{\text{atmosphere}, i}(0) = \lim_{r \rightarrow 0} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{z_i e}{r} \left\{ \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right) - 1 \right\} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a \Rightarrow \phi_{\text{atmosphere}, i}(0) = - \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{z_i e}{r_0}$$

中心イオンの電荷を Q とする。 r_D は $Q = z_i e$ のときの値で定数とする。

Q が 0 から $z_i e$ まで増加させるのに必要なモルあたりの仕事 $w_{e,i}$

$$\phi_{\text{atmosphere}, i}(0) = -\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r_D}$$

$$\int_0^{w_{e,i}} dw_{e,i} = \int_0^{z_i e} N_A \phi_{\text{atmosphere}, i}(0) \cdot dQ$$

$$w_{e,i} = -\frac{N_A z_i^2 e^2}{8\pi\epsilon r_D} = -\frac{z_i^2 F^2}{8\pi N_A \epsilon r_D}$$

p, q-電解質の溶液について。

$$w_e = p w_{e,+} + q w_{e,-}$$

$$= -\frac{F^2}{8\pi N_A \epsilon r_D} (p z_+^2 + q z_-^2)$$

電気的中性より $p z_+ + q z_- = 0$

$$\begin{aligned} p z_+^2 + q z_-^2 &= (-q z_-) z_+ + (-p z_+) z_- \\ &= -(p+q) z_+ z_- \end{aligned}$$

$$w_e = G_m - G_m^{\text{ideal}} = RT \ln \gamma_{\pm}^{(p+q) F}$$

$$\begin{aligned} \ln \gamma_{\pm} &= \frac{1}{(p+q) RT} \cdot \frac{F^2}{8\pi N_A \epsilon r_D} (p+q) z_+ z_- \\ &= \frac{F^2 z_+ z_-}{8\pi N_A \epsilon RT r_D} \end{aligned}$$

$z_+ z_- = -|z_+ z_-|$ と表す。

$$r_D = \left(\frac{\epsilon RT}{2 I b^{\theta} \rho' F^2} \right)^{\frac{1}{2}} \text{ を代入すると。}$$

$$\ln \gamma_{\pm} = -|z_+ z_-| \cdot \frac{F^3}{4\pi N_A} \left(\frac{b^{\theta} \rho'}{2 \epsilon^3 R^3 T^3} \right)^{\frac{1}{2}} I^{\frac{1}{2}}$$

$$A = \frac{F^2}{4\pi N_A \ln 10} \left(\frac{b^{\theta} \rho'}{2 \epsilon^3 R^3 T^3} \right)^{\frac{1}{2}} \text{ とすると。}$$

$$\log \gamma_{\pm} = -A |z_+ z_-| I^{\frac{1}{2}}$$

デバイ-ヒュッケルの極限法則